

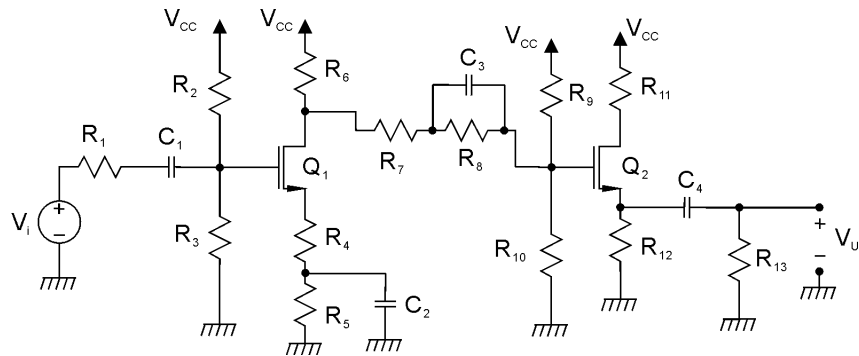
# ELETTRONICA DIGITALE

## Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 09 giugno 2015

### Esercizio A

$R_1 = 50 \Omega$	$R_{11} = 4 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 200 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 2500 \Omega$
$R_3 = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 10 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 100 \Omega$	$C_1 = 220 \text{ nF}$
$R_5 = 1400 \Omega$	$C_2 = 33 \text{ nF}$
$R_6 = 3600 \Omega$	$C_3 = 100 \text{ nF}$
$R_7 = 100 \Omega$	$C_4 = 680 \text{ pF}$
$R_9 = 20 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$
$R_{10} = 8 \text{ k}\Omega$	



$Q_1$  e  $Q_2$  sono transistori MOS a canale n resistivi, con la corrente di drain in saturazione data da  $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$  con  $k = 0.5 \text{ mA/V}^2$  e  $V_T = 1 \text{ V}$ ;

Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza  $R_8$  in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di  $Q_2$  sia 10 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificarne la saturazione. (R:  $R_8 = 1900 \Omega$ )
- 2) Determinare l'espressione e il valore di  $V_U/V_i$  alle frequenze per le quali  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  e  $C_4$  possono essere considerati dei corto circuiti. (R:  $V_U/V_i = -2.9$ )
- 3) **(Solo per 12 CFU)** Determinare la funzione di trasferimento  $V_U/V_i$  e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R:  $f_{z1} = 0 \text{ Hz}$ ;  $f_{p1} = 10.84 \text{ Hz}$ ;  $f_{z2} = 3444.91 \text{ Hz}$ ;  $f_{p2} = 11483 \text{ Hz}$ ;  $f_{z3} = 837.66 \text{ Hz}$ ;  $f_{p3} = 1006.72 \text{ Hz}$ ;  $f_{z4} = 0 \text{ Hz}$ ;  $f_{p4} = 22468.9 \text{ Hz}$ )

### Esercizio B

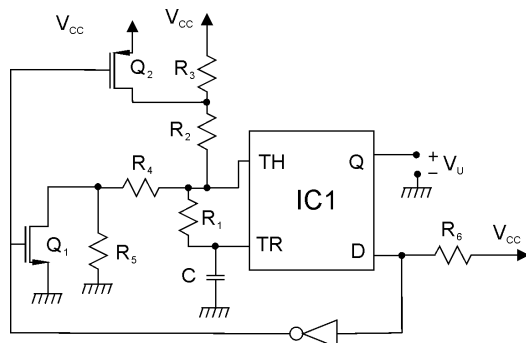
Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\overline{AB} + C)(\overline{CD} + \overline{E}) + \overline{CE}(\overline{A} + \overline{B}) + \overline{DE}$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

### Esercizio C

$R_1 = 3 \text{ k}\Omega$	$R_5 = 20 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 4 \text{ k}\Omega$	$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 5 \text{ k}\Omega$	$C = 100 \text{ nF}$
$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$



Il circuito  $IC_1$  è un NE555 alimentato a  $V_{CC} = 6 \text{ V}$ ,  $Q_1$  ha una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = 1 \text{ V}$  e  $Q_2$  una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = -1 \text{ V}$ , l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R:  $f = 2008 \text{ Hz}$ ).